

### 超低 VDS, 十六位恒流低功耗 LED 节能屏专用驱动

#### 一,特点

- ◆16 通道恒流输出
- ◆电流输出大小不因输出端负载电压变化而变化
- ◆恒流电流输出范围广,
- 3-90mA@VDD=5V, 3-60mA@VDD=3. 3v
- ◆极为精确的电流输出值:

通道间偏差(一般值)<±1.5% 芯片间偏差(一般值)<±3%

- ◆通过调节外部电阻,可设定电流输出值
- ◆工作电压 3.3v~5.5v
- ◆输出端瞬间耐受电压为 20v
- ◆最小 0E 宽度: 70n(实测更低)(保持输出均匀一致的前提下)
- ◆封装形式:

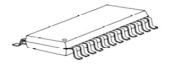
SSOP24 (0. 635°D1. 40), SSOP24 (1. 0-D1. 50)

#### ◆低转折电压表:

VDD	IOUT	VDS
	20mA	≤0.2V
3. 3v	45mA	≤0.3V
	60mA	≦0.5V
	20mA	≤0.2V
3.8v	45mA	≦0.3V
	60mA	≦0.5V
	20mA	≤0.2V
5.0	45mA	≤0.3V
5. 0v	60mA	≦0.5V
	90mA	≦0.7V

#### 二、概述

HX5035 是专为 LED 显示面板设计的低功耗、大电流驱动 IC,它内建的 CMOS 移位寄存器、锁存器以及输出控制单元,可以将串行输入的数字信号转换成模拟输出的恒定电流信号,从而驱动 LED 器件发光。HX5035 的输入电压范围 3.3~5.5v,提供 16 通道恒流输出,通过调节系统电阻 Rext,其恒定电流输出范围为 3-90mA;单颗 HX5035 每个输出通道之间的电流偏差(一般值)小于±1.5%,多颗 HX5035 之间的输出电流偏差(一般值)小于±3%;电流随输出端电压变化被控制在 0.1%/v 以内;电流随电源电压和环境温度的变化被控制在 1%以内。



CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

GF: SSOP24-1.00

GP: SSOP24-0.635



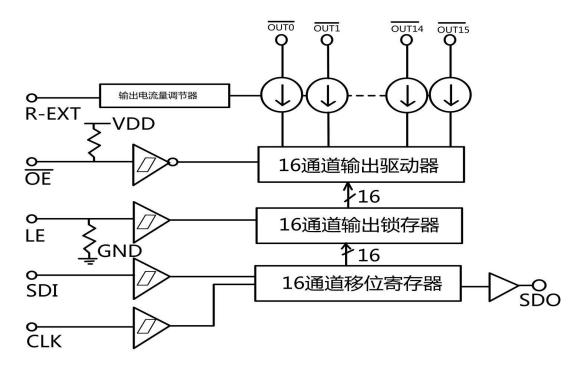
### 三、管脚图

脚位图	序号	管脚	功能
	1	GND	控制逻辑及驱动电流的接地端
	2	SDI	串行数据输入端
1 GND VDD 24	3	CLK	时钟信号的输入端,时钟上升沿时数据移位
2 SDI R-EXT 23 3 CLK SDO 22	4	LE	数据锁存控制端。当 LE 为高电平时,串行数据会被传入
4 LE OE 21 5 OUTO OUT15 20			至输出锁存器; 当 LE 为低电平时,数据会被锁存。
6 OUT1 J O OUT14 19	1	OUT0-15	恒流源输出端
7 OUT2 OUT13 18 8 OUT3 OUT12 17	21	0E	输出使能控制端。当 OE 为低电平时,即启动 OUTO-15 输
9 OUT4 O OUT11 16			出; 当 OE 为高电平时, OUTO-15 输出会被关闭
10 OUTS OUT OUT 15	22	SD0	串行数据输出端,可接至下一个芯片的 SDI 端口
12 OUT7 OUT8 13	23	R-EXT	连接外接电阻的输入端,此外接电阻可设定所有输出通道
			的输出电流
	24	VDD	芯片电源

## 四、应用领域

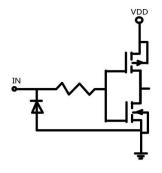
- ◆LED 节能显示屏
- ◆护栏管
- ◆LED 显示设备

## 五、内部框图典型应用

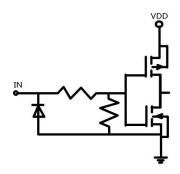




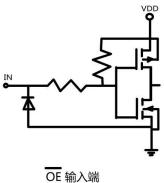
#### 输入输出等效电路

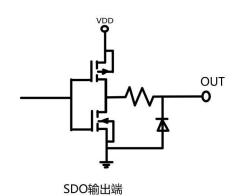


CLK, SDI输入端

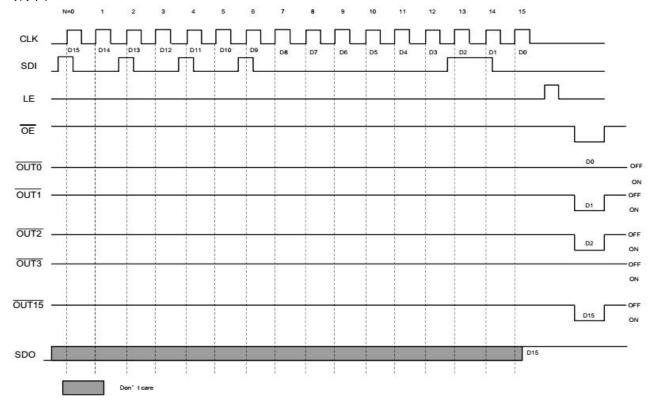


LE 输入端





时序图:





#### 真值表:

CLK	LE	0E	SDI	$0\overline{010001700115}$	SD0
<b>↑</b>	Н	L	Dn	Dn Dn−7 Dn−15	Dn-15
<b>↑</b>	L	L	Dn+1	不变	Dn−14
<b>↑</b>	Н	L	Dn+2	Dn+2Dn+5Dn−13	Dn-13
<b>↓</b>	X	L	Dn+3	Dn+2Dn+5Dn−13	Dn-13
<b></b>	X	Н	Dn+3	使 LED 不亮	Dn-13

## 六、极限参数

符号	描述	参考范围	单位
VDD	电源电压	0~7.0	V
VIN	输入端电压 SDI	-0. 4 \ Vdd+0. 4	V
IOUT	输出端电流	90	mA
VDS	输出端瞬间耐受电压	-0. 5-20. 0	V
FCLK	时钟频率	25	MHZ
IGND	接地端电流	1450	mA
PD	消耗功率	1.88	W
RTH (J-A)	热阻值	66. 66	°C/W
TOPR	IC 工作时环境温度	-40~+85	${\mathbb C}$
TSTG	IC 存储时环境温度	-55-150	${\mathbb C}$

注: 极限参数超过上表中规定的工作范围可能导至器件损坏。而工作在以上条件下可能会导致器件的可靠性。





# 七、直流特性

VDD=5V

特	性	符号	测量条	:件	最小值	一般值	最大值	单位
电源	电压	VDD	_		4. 5	5. 0	5. 5	V
输出端瞬间	可耐受电压	VDS	0 <del>UT0-</del> 0 <del>UT15</del>		-	-	20.0	V
		IOUT	参考直流特( 路	生测试电	3	l	90	mA
输出站	市电流	IOH	SD0		_		-1.0	mA
		IOL	SD0		-	-	1.0	mA
输入端电	高电平	VIH	Ta=-40~8	85℃	0. 7*VDD	-	VDD	V
压	低电平	VIL	Ta=-40-8	85℃	GND	-	0.3*VDD	V
输出端	漏电流	IOH	VDS=1	7V	-	-	0.5	uA
<i>t</i> 公山-迦-由 []	CDO	VOL	I0L=+1	.MA	-	0.2	0.3	V
输出端电压	E SDO	VOH	IOH=-1	MA	3. 5	3.6	-	V
电流偏移量 间		dIOUT1	IOUT=20mA VDS=0.25V	Rext=8 90Ω	-	±1.5	±3.0	%
电流偏移量	量 2(通道 )	dIOUT2	IOUT=20mA VDS=0.25V	Rext=8 90Ω	-	±3.0	±6.0	%
电流偏移量		%/dVDS	输出电压=0	. 5 <sub>~</sub> 1. 5v	-		±0.1	%/V
电流偏移量		%/dVDD	输出电压=3	. 4~4. 2v	_		±1.0	%/V
Pu11-u	p 电阻	RIN(UP)	0 <u>E</u>		150	330	560	KΩ
Pull-do	wn 电阻	RIN(DOWN)	LE		150	330	560	KΩ
		IDD(off)1	Rext=0 0UT0-0UT1		-		4.0	
	0FF	IDD(off)2	Rext=11 0UT0-0UT1		-		5. 0	
电压源输 出电流		IDD(off)3	Rext=47		-		8. 5	mA
		IDD(on)1	Rext=11 OUTO-OUT		-		5. 5	
	ON	IDD(on)2	0UT0-0UT15=on  Rext=470 Ω  0UT0-0UT15=on		-		9. 0	



VDD=3.8V

特	性	符号	测量统	<b>条件</b>	最小值	一般值	最大值	单位
电源	电压	VDD	-		3. 4	3.8	4.2	V
输出端瞬间	可耐受电压	VDS	0 <del>UT0-</del> 0 <del>UT15</del>		-	-	20.0	V
/A 1, 3/4, 1, 32-		IOUT	参考直流特 路		3	-	60	mA
输出站	<b>吊</b> 电流	IOH	SDO	)	-	_	-1.0	mA
		IOL	SDO	)	-	_	1.0	mA
输入端电	高电平	VIH	Ta=-40	85℃	0.7*VDD	_	VDD	V
压	低电平	VIL	Ta=-40	85℃	GND	_	0. 3*VDD	V
输出端	漏电流	IOH	VDS=1	17V	-	_	0.5	uA
		VOL	IOT=+	1MA	-	0. 2	0.3	V
输出端电压	E SDO	VOH	I0H=-	1MA	3. 5	3. 6	_	V
电流偏移量	量 1 (通道 )	dIOUT1	IOUT=20mA VDS=0.25V	Rext=89 0Ω	-	±1.5	±3.0	%
电流偏移量	量 2(通道 )	dIOUT2	IOUT=20mA Rext=89 VDS=0.25V 0 Ω		-	±3.0	±6.0	%
电流偏移量		%/dVDS	输出电压=	0. 5~1. 5v	-		±0.1	%/V
电流偏移量		%/dVDD	输出电压=	3. 4-4. 2v	_		±1.0	%/V
Pu11-u	p 电阻	RIN(UP)	0E	-	150	330	560	KΩ
Pull-do	wn 电阻	RIN(DOWN)	LE		150	330	560	KΩ
		IDD(off)1	Rext=c	-	-		4.0	
	OFF	IDD(off)2	Rext=11		-		5. 0	
电压源输 出电流		IDD(off)3	Rext=470 Ω 0UT0-0UT15=off		-		8. 5	mA
	0	IDD (on) 1	Rext=11		-		5. 5	
	ON $IDD (on) 2 \qquad \frac{\text{Rext=470 }\Omega}{\text{OUT0-OUT15=on}}$		_		9. 0			

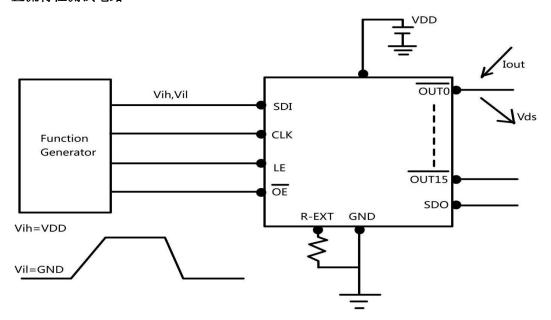


VDD=3.3V

特	性	符号	测量	条件	最小值	一般值	最大值	单位
电源	电压	VDD	_		3.0	3. 3	3.6	V
输出端瞬间	可耐受电压	VDS	0 <del>UT0-</del> (	OUT15	-	-	20.0	V
+A 11 244 -L 19-		IOUT	参考直流特 路		3	-	60	mA
输出站	<b>吊</b> 电流	IOH	SD	0	-	-	-1.0	mA
		IOL	SD	0	-	-	1.0	mA
输入端电	高电平	VIH	Ta=-40	-85℃	0.7*VDD	-	VDD	V
压	低电平	VIL	Ta=-40	-85℃	GND	-	0. 3*VDD	V
输出端	漏电流	IOH	VDS=	17V	-	-	0.5	uА
<i>+</i> A 11 241 <del>1.</del> F	CD0	VOL	IOT=-	+1MA	-	0. 2	0.3	V
输出端电压	E SDO	VOH	IOH=-	-1MA	3. 5	3. 6	-	V
电流偏移量	<b>a</b> 1 (通道 )	dIOUT1	IOUT=20mA VDS=0. 25V	IOUT=20mA Rext=89		±1.5	±3.0	%
电流偏移量	量 2(通道 )	dIOUT2	IOUT=20mA Rext=89 VDS=0.25V 0 Ω		-	±3.0	±6.0	%
电流偏移量		%/dVDS	输出电压=	€0. 5~1. 5v	_		±0.1	%/V
电流偏移量		%/dVDD	输出电压=	3. 4-4. 2v	-		±1.0	%/V
Pull-u	p 电阻	RIN(UP)	OH	<u>.</u>	150	330	560	KΩ
Pull-do	wn 电阻	RIN(DOWN)	LF	€	150	330	560	KΩ
		IDD(off)1	Rext= 0UT0-0UT		-		3. 0	
L FT VF	0FF	IDD(off)2	Rext=1		_		5. 0	
电压源 输出电 IDD(off)3		Rext=4 0UT0-0UT		-		9.0	mA	
流	017	IDD (on) 1	Rext=1 OUTO-OU		_		5. 0	
	ON	IDD (on) 2		Rext=470 Ω  OUTO-0UT15=on			8. 0	



#### 直流特性测试电路



# 八、动态特性

VDD=5. OV

	特性	代表符号	测量条件	最小值	一般值	最大值	单位	
3~ ) E = 1 }—	CLK-OUTn	tp1H1		_	50	70	ns	
延迟时间	LE-OUTn	tp1H2		_	50	70	ns	
(低电位到 高电位)	OE-OUTn	tp1H3		_	50	70	ns	
间电应/	CLK-SDO	tp1H		_	20	40	ns	
7-f \12 p   1-i\22	CLK-OUTn	tp1H1		_		110	ns	
延迟时间	LE-OUTn	tp1H2	VDD=5V	_		110		
(高电位到 低电位)	OE-OUTn	tp1H3	VIH=VDD	_		110	ns	
似电位力	CLK-SD0	tp1H	VIL=GND			40		
	CLK	Tw (CLK)	Rext=890 Ω Iout=20mA VLED=3.3V	20	-	-	ns	
脉冲宽度	LE	tw(L)		20	-	-	ns	
	OE	tw(oF)		60	-	-	ns	
奇偶通道交 错延迟时间	Outputgroup1-out putgroup2	Tstag1	RL=150 $\Omega$ CL=10pf		5	10	ns	
LE 的	J Hold Time	th(L)	CSD0=10pf	10	-	1		
LE 的	LE的 Setup Time			5	ı	ı		
CLK 最大上升时间		tr		_	-	500		
CLK 最大下降时间		Tf		_	-	500	ns	
电流输出站	端的电位上升时间	tor		25	30			
电流输出站	端的电位下降时间	Tof		40	50			



#### VDD=3.8V

	特性	代表符号	测量条件	最小值	一般值	最大值	单位
	CLK-OUTn	tplH1		_		70	ns
延迟时间	LE-OUTn	tp1H2		_		70	ns
(低电位到 高电位)	0E-0UTn	tp1H3		_		70	ns
同电型/	CLK-SDO	tp1H		_		45	ns
7~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	CLK-OUTn	tp1H1		_		120	ns
延迟时间	LE-OUTn	tp1H2	VDD=3.8V	_		120	
(高电位到 低电位)	OE-OUTn	tp1H3	VIH=VDD	_		120	ns
1版电位/	CLK-SD0	tp1H	VIL=GND			40	
	CLK	Tw (CLK)	Rext=890 Ω	20	-	-	ns
脉冲宽度	LE	tw(L)	Iout=20mA	20	-	-	ns
	OE	tw(oF)	VLED=3.3V	70	-	-	ns
奇偶通道交 错延迟时间	Outputgroup1-out putgroup2	Tstag1	RL=150 Ω CL=10pf		6	12	ns
LE的	J Hold Time	th(L)	CSD0=10pf	10	-	-	
LE 的	LE的 Setup Time			5	-	-	
CLK 最大上升时间		tr		_	-	500	
CLK 最大下降时间		Tf		_	-	500	ns
电流输出站	端的电位上升时间	tor		30	35		
电流输出站	端的电位下降时间	Tof		45	55		

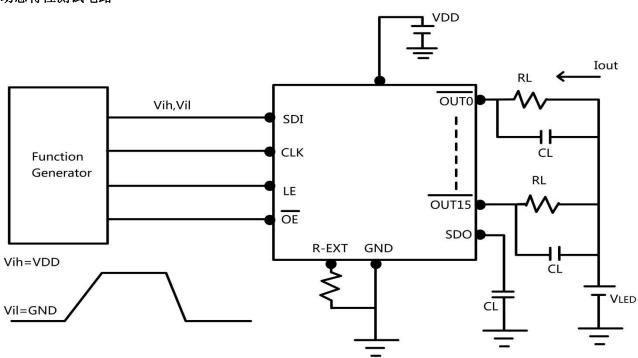
#### VDD=3.3V

	特性	代表符号	测量条件	最小值	一般值	最大值	单位
	CLK-OUTn	tp1H1		-		70	ns
延迟时间	LE-OUTn	tp1H2	VDD=3.3V	-		70	ns
(低电位到 高电位)	0E-0UTn	tp1H3	VIH=VDD	-		70	ns
同电池ノ	CLK-SD0	tp1H	VIII-VDD VIL=GND	-		50	ns
	CLK-OUTn	tp1H1	Rext=890 Ω	-		130	ns
延迟时间	LE-OUTn	tp1H2	Iout=20mA VLED=3.3V	-		130	
(高电位到 低电位)	0E-0UTn	tp1H3		-		130	ns
低电型ノ	CLK-SD0	tp1H	RL=150 Ω			40	
	CLK	Tw (CLK)	CL=10pf	20	-	-	ns
脉冲宽度	LE	tw(L)	CSD0=10pf	20	-	-	ns
	OE	tw(oF)		80	_	_	ns



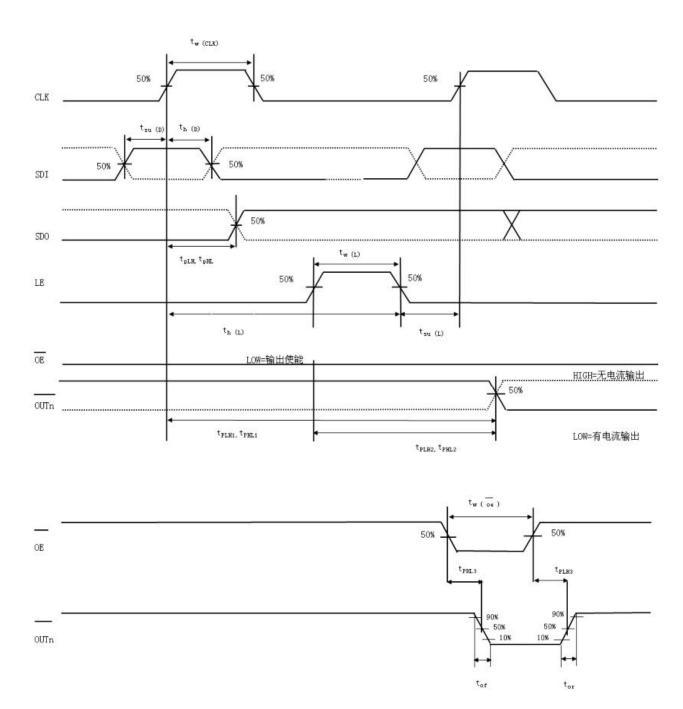
奇偶通道交 错延迟时间	Outputgroup1-out putgroup2	Tstagl		7	14	ns
LE的	J Hold Time	th(L)	10	_	-	
LE 的	Setup Time	Tsu(L)	5	-	-	
CLK 最	<b>是</b> 大上升时间	tr	-	-	500	
CLK 最	<b>是</b> 大下降时间	Tf	-	ı	500	ns
电流输出站	端的电位上升时间	tor	30	40		
电流输出站	端的电位下降时间	Tof	50	60		

#### 动态特性测试电路





# 九、时序波形图

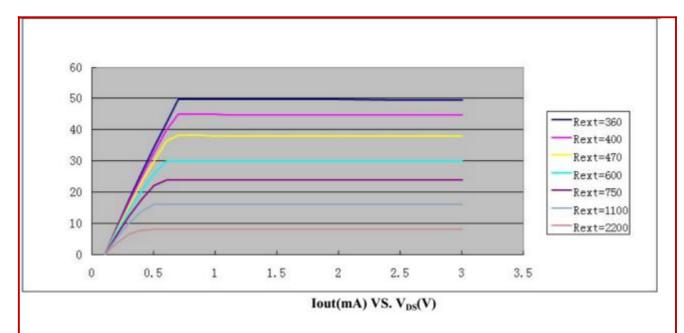


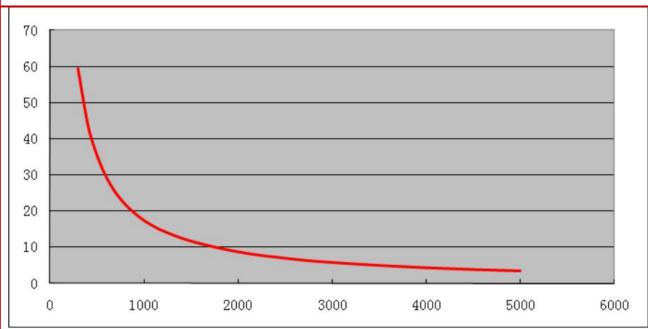
## 十、应用信息

HX5035 采用了精确电流驱动技术,同一芯片的不同通道间,不同芯片之间的电流差异极小。

- ①通道间的电流差异(一般值)<±1.5%,芯片间的电流差异(一般值)<±3%
- ②具有不受负载电压影响的电流输出特性,如下图所示。输出电流将不随 LED 正向压降 VF 的变化而变化。







Iout(mA) VS. R<sub>ext</sub> (Ω)

#### 调节输出电流

HX5035 通过外接电阻 Rext 来调节输出电流 Iout, 计算公式为:

VR-EXT=1.18V

IOUT = (VR - EXT / Rext) \* 15

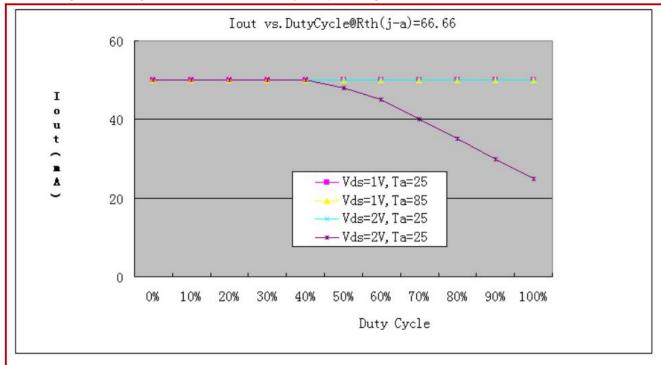
如: 当 Rext=470 Ω 时,输出电流约为 38mA; 当 Rext=1100 Ω 时,输出电流约为 17mA.

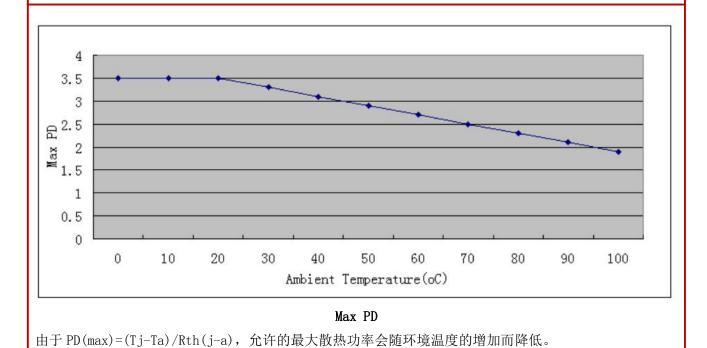
#### 封装体散热功率(PD)

封装体的最大散热功率由公式 PD(max)=(Tj-Ta)/Rth(j-a)决定,实际功率为 PD(act)=(IDD\*VDD)+(IOUT\*Duty\*VDS\*16)



为保持 PD(act) 〈PD(max), 可输出的最大电流与 duty cycle 的关系为: IOUT=((Tj-Ta)/Rth(j-a)-IDD\*VDD)/(VDS\*Duty\*16), 其中 Tj=150℃

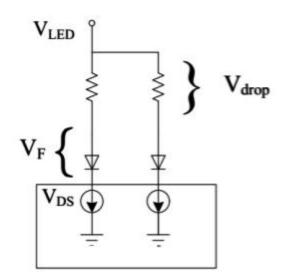


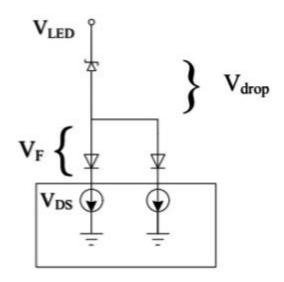


#### 负载端供应电压(VLED)

由于封装散热能力的限制,输出端电压(VDS)的最佳操作范围是 0.4~1.0V,输出电流 IOUT 为 3~45mA。如果 VDS=VLED-VF,且 VLED=5V 时,此时过高的输出端电压(VDS)可能导至 PD(act)>PD(max),此时可以考虚用电阻或 Zener Diode 来分压,以降低 VDS 电压。







#### 减低动态噪声

要尽量从以下几个方面来减低 LED 显示的动态噪声:

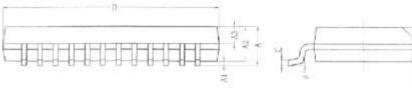
- ①电源需要有大电流的驱动能力。
- ②地线(GND)的布线要尽量宽,最好能有单独一层。
- ③电源线(VDD)的布线也要尽量宽,最好有单独一层。
- ④系统板两端的 VDD 和 GND 之间应各放一颗 470uF 的电容。
- ⑤最好在芯片的 VDD 与 GND 之间放置一颗 0.1uf 贴片退藕电容。

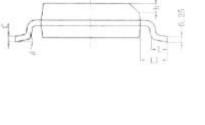
# 十一、订货信息

完整型号	说明	最小包装(Pcs)	环保	
HX5035GP	第一排型号	2500 /舟	<b>⊥</b> . <i>k</i> n	
XXXX	第二排年周	2500/盘	无铅	
HX5035GF	第一排型号	9000 /환	无铅	
XXXX	第二排年周	2000/盘		



### 十二、封装尺寸图

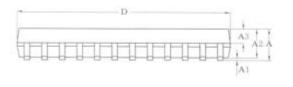




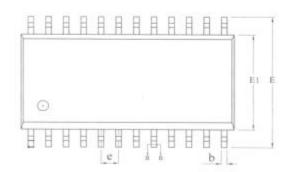
1	BASE WITH	
		SECT

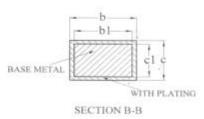
SYMBOL	SHILLISHTER			
	M04	1004	MAX	
A	1.35	1.60	1:75	â
A.1	0.10	9.15	0.21	
A2	1.30	1.40	1.50	
A3	0.60	0.65	0.70	
h	0.23	-	0.30	à
51	0.22	0.25	0.28	
-0	0.21		0.25	
et	0.19	0.20	0.21	
D	8.56	8.65	8.76	A
E	5.80	6.00	6.20	
El	3.80	3.90	4.09	A
c	0.635BSC			
h	0.25	-	0.50	
L.	0.50	-	0.80	
LI	1.05BSC			
0:	0		8:	

#### SSOP24(0.635-D1.40)









SYMBOL 0.05 0.15 AI 0.62 A3 0.39 0.38 0.15 0.14 0.15 12.80 13.00 D 13.20 7.70 7.90 8.10 5.80 6.00 6.20 1.00BSC 0.25 0.45 0.65

SSOP24(1.0-D1.50)